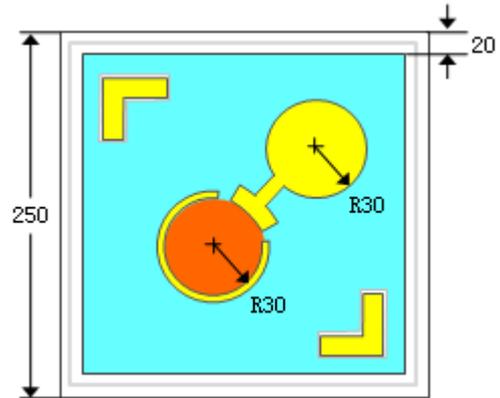




S-10ACPD02-D GaInAs/InP-PIN 芯片 (chip) 特性参数

◆ 特性描述:

- Φ60 μm 有源面
- 光谱响应 1000-1650 nm
- 高速响应
- 低暗电流
- 高量子效率
- 155/622 Mb/s、1.25Gb/s PIN/TIA 适用



◆ 物理参数

芯片尺寸	250μm × 250μm
芯片厚度	150μm ± 10μm
光敏面直径	60 μm
焊盘直径	60 μm

◆ 绝对最大值 (T=25°C)

参 数	符 号	单 位	数 值	备 注
正向电流	I_F	mA	10	
反向电压	V_r	V	20	
接触温度		°C	300	60 s
工作温度	T_{OP}	°C	-40 -- +85	
存储温度	T_{stg}	°C	-40 -- +100	

◆ 光电特性参数 (T=25°C):

参 数	符 号	单 位	最小植	典型植	最大植	测试条件
有源面	ϕ	μm		60		
响应度	R_e	A/W	0.85	0.90		$\lambda = 1310\text{nm}$
			0.90	0.95		$\lambda = 1550\text{nm}$
暗电流	I_D	nA		0.05	0.5	-5V
电容	C_D	PF		0.4	0.6	-5V, 1MHz
击穿电压	V_{BR}	V	30			10μA
带宽	BW	GHz	2.0			-5V, 50 Ω

◆ 其他说明

- 芯片静电等级为 1 级，使用，运输时注意静电防护